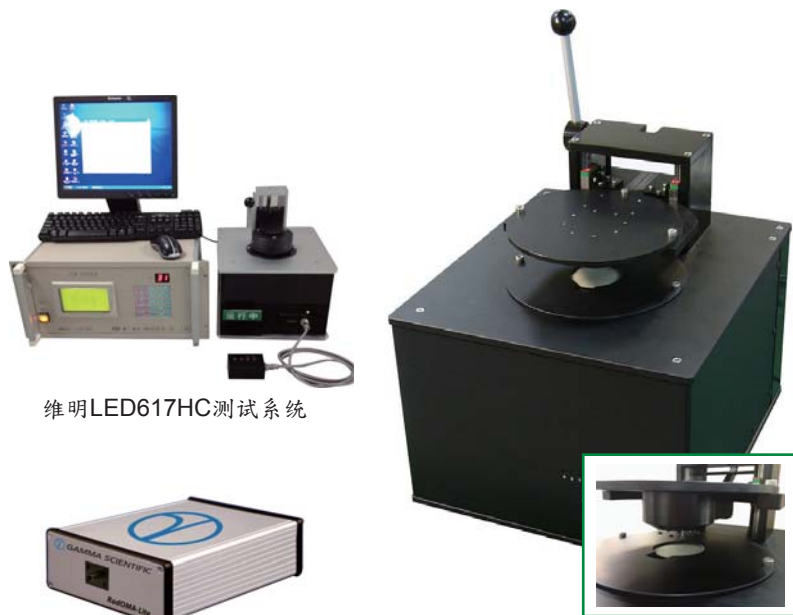


Model M2442 LED GaN EPI Wafer Tester 快速EL特性测试系统

特点：

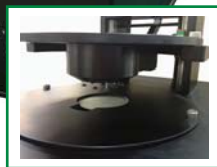
- 2"~6" LED EL特性Wafer Level量测，可测试亮度，波长，色座标，半高宽，电学参数等参数
- LED Wafer 平均分布5点，9点或更多点位置量测
- 6ψ大面积探针保证接点安全，防止人工点钢球误差
- 密闭式测试环境，屏蔽外界光影响，测试精度高
- 电子切换开关，接触电阻低，寿命长
- 搭配两款测试主机皆可实现自动测试，数据存储分析功能。



维明LED617HC测试系统



GAMMA分光光谱仪



LED GaN EPI Wafer Tester
快速EL特性测试系统

系统配置：

- M2442S-9A 9点自动测试平台
- 桌上型电脑（含测试软件）
- 9点点钢球对位治具
- 测试主机（可选）：
维明LED617HC LED光电参数测试仪
GAMMA GS-1190光谱仪+
Keithley 2400源表

维明LED617HC测试系统规格

测试项目	测试条件				测试值
	电源	档位范围	解析度	准确度	档位范围
VF	IF	0.0001~0.4000mA	0.0001mA	±(1%+0.0002mA)	0.000~8.000V
		0.401~4.000mA	0.001mA	±(1%+0.002mA)	
		4.01~40.00mA	0.01mA	±(1%+0.02mA)	
		40.1~2000.0mA	0.1mA	±(1%+0.2mA)	
VZ	IZ	0.01~40.00uA	0.01uA	±(1%+0.02uA)	0.0~200.0V
		40.1~400.0uA	0.1uA	±(1%+0.2uA)	
		401~1000uA	1uA	±(1%+2uA)	
IR	VR	0.1~200.0V	0.1V	±(0.25%+0.2V)	0.000~4.000uA
					4.01~40.00uA 40.1~400.0uA

测试项目	测试条件			测试值		
	电源	档位范围	解析度	准确度		
LOP (Iv或Ie 或光通量)	IF					
				同VF	0.000~4.000 4.01~40.00 40.1~400.0 401~5000	
		λd			同VF	360.0~440.0nm 440.0~650.0nm 650.0~700.0nm
			λc			370.0~720.0nm
λp				310.0~1130.0nm		
HW				10.0~999.9nm		

GAMMA分光光谱仪规格

规格			
探测器	CCD 线性阵列	输入源	600G/mm
	• 像素：2048		光纤：SMA 905 ,1000μm core Ø fiber
	• 检测像素尺寸：14μm x 200μm		(N.A)数值孔径= 0.2
尺寸 (mm)	6.3" L x 4.1" W x 2.1" H (160mm L x 103mm W x 54mm H)	动态范围	16 bit or 65536:1
重量	0.7 lbs (0.3 kg)	电脑介面	USB 2.0 ,16 bit ,800KHz
光谱范围	380-780 nm	输入电源	5VDC, 140 mA (电源消耗率：0.6 - 0.7W)
光谱解析度	0.25 - 0.35nm 取决于狭缝宽度和光纤直径	温度范围	15°C to 40°C
		软件	RadOMA-Lite software package

量测规格	
峰值波长精确度	± 0.5 nm
主波长精确度	± 0.5 nm
光通量	范围取决于球体大小/精确度：± 4%
CIE1931 x,y 色座标精确度	± 0.003
色温 (CCT)	范围：1000K ~ 100,000K 精确度：± 5%
半高宽精确度 (FWHM)	± 0.5nm
光谱纯度	± 5%
演色性 (CRI)	± 5%